МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Лень А.Е.

3BIT

Дослідження ВАХ діодів

Київ. КНУ ім. Т. Шевченка, 2021

УДК 001.006 (004.21)

I-72

Укладачі: А.Е. Лень

I-72 Звіт. Дослідження ВАХ діодів./ укл. А.Е. Лень— К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2021. — 9 с. (Укр. мов.)

Наведено загальний звіт виконання роботи з моделювання електронних схем у програмі Multisim $^{\rm TM}$.

УДК 001.006 (004.21)

ББК 73Ц

© Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, 2021

РЕФЕРАТ

Звіт про дослідження ВАХ діодів: 9 с., 4 рис.

Мета роботи – навчитися одержувати зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, дослідити властивості р-п-переході напівпровідникових діодів різних типів.

Об'єкт дослідження – діоди: випрямлювальний, стабілітрон, світлодіод.

Предмет дослідження – теоретичні основи, принципи роботи, фізичний зміст і застосування діодів.

Методи дослідження — 1) одержання зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, який працює в режимі характериографа; 2) побудова ВАХ діодів шляхом вимірювання певної кількості значень сили струму $I_{\rm Д}$, що відповідають певним значенням та полярності напруги $U_{\rm Д}$, і подання результатів вимірів у вигляді графіка.

ДІОДИ, P-N ПЕРЕХІД, СВІТЛОДІОДИ, НАПІВПРОВІДНИКИ, ВАХ ДІОДІВ, MULTISIM.

Зміст

| 1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ | 5 |
|-------------------------|---|
| | |
| | |

1. Теоретичні відомості

Напівпровідниковий діод (англ. semiconductor diode) — це напівпровідниковий прилад з одним p-n—переходом і двома виводами.

p-n–**перехід** (англ. p-n junction) – перехідний шар, що утворюється на межі двох областей напівпровідника, одна з яких має провідність n-типу, а інша — провідність p-типу.

Вольт-амперна характеристика (ВАХ) діода (англ. current-voltage characteristic) — це залежність сили струму Ід через p-n—перехід діода від величини і полярності прикладеної до діода напруги Uд.

Характериограф – електронно-променевий прилад, на екрані якого можна спостерігати графіки функцій будь-яких фізичних величин, що можуть бути перетворені у пропорційні їм напруги, наприклад, графіки залежності сили струму Ід від напруги Uд.

2. Практична частина

Для дослідження ВАХ випрямлювального діода, стабілітрона та світловипромінювального діода було використано два резистори номіналом 1 кОм та 10 Ом, а також генератор сигналів та осцилограф у режимі характериографа, на екрані якого ми й спостерігали ВАХ вищезгаданих діодів (рис. 1). На генераторі була виставлена пилкоподібна форма сигналу частотою 1 Гц та амплітудою 10 В. Перемикаючи ключі, ми змінювали досліджувані діоди.

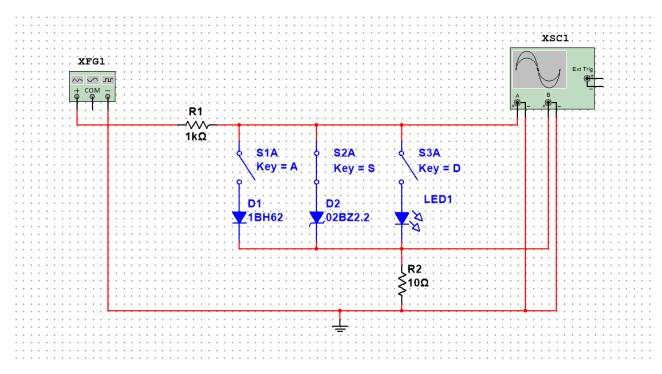


Рис. 1. Схема підключення випрямлювального діода, стабілітрона та світловипромінювального діода з під'єднаними осцилографом та генератором сигналів.

1. Випрямлювальний діод

На рис. 2 ми можемо бачити ВАХ випрямлювального діода. Видно, що при зворотному включенні наш діод струму не пропускає, а при прямому є експоненціальні залежність між струмом та напругою, що співпадає з очікуваннями.

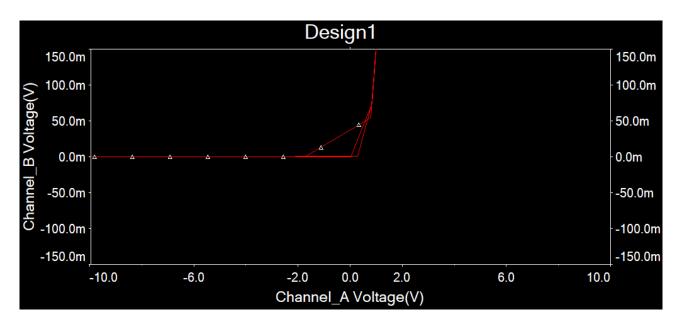


Рис. 2. ВАХ випрямлювального діода

2. Стабілітрон

На рис. 3 ми можемо бачити ВАХ стабілітрона. Видно, що при зворотному включенні наш діод до пробою струму не пропускає, але при пробої отримуємо непарно відбиту до прямого включення залежність струму від напруги, а при прямому ϵ експоненціальні залежність між струмом та напругою, що співпадає з очікуваннями.

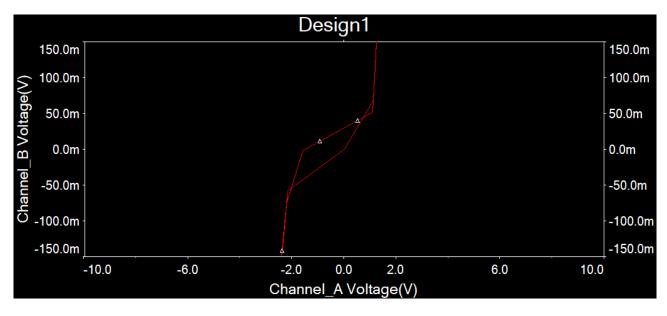


Рис. 3. ВАХ стабілітрона

3. Світловипромінювальний діод

На рис. 4 ми можемо бачити ВАХ світловипромінювального діода. Видно, що при зворотному включенні наш діод струму не пропускає, а при прямому є експоненціальні залежність між струмом та напругою, яка є пологішою ніж для випрямляючого діода, що співпадає з очікуваннями.

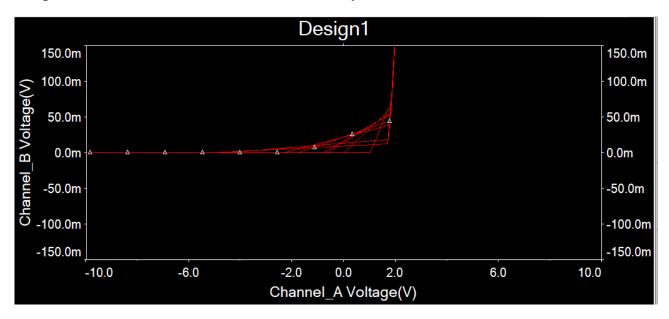


Рис. 4. BAX світловипромінювального діода

Висновки

У ході даної лабораторної роботи ми навчилися одержувати зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, дослідили властивості p-n—переходів напівпровідникових діодів різних типів. Ми одержали зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, який працює в режимі характериографа, і таким чином наочно побачили відмінності між різними типами діодів, що дає уявлення про їх можливе застосування

Список використаної літератури

- 1. Методичні вказівки до практикуму «Основи радіоелектроніки» для студентів фізичного факультету / Упоряд. О.В.Слободянюк,
- 2. Ю.О.Мягченко, В.М.Кравченко.- К.: Поліграфічний центр «Принт лайн», 2007.- 120 с.
- 3. Ю.О. Мягченко, Ю.М. Дулич, А.В.Хачатрян "Вивчення радіоелектронних схем методом комп'ютерного моделювання": Методичне видання. К.: 2006.- с.